

Сведения о члене экспертной комиссии

1	ФИО (полностью)	Мармалюк Александр Анатольевич
2	Дата рождения (полная)	27.03.1970
3	Гражданство	Российская Федерация
4	Ученая степень (с указанием шифра специальности научных работников, по которой защищена диссертация)	доктор технических наук (специальность – 05.27.06 – Технология и оборудование для производства полупроводников, материалов и приборов электронной техники)
5	Ученое звание (по кафедре, специальности)	
6	Место работы:	
	Почтовый индекс, адрес, web-сайт, электронный адрес организации	117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 3, корп. 1, https://www.polyus.info/ , bereg@niipolyus.ru
	Полное наименование организации в соответствии с уставом	Акционерное общество «Научно-исследовательский институт «Полнос» имени М.Ф. Стельмаха»
	Ведомственная принадлежность организации	ГК «Ростех»
	Тип организации	Акционерное общество
	Наименование подразделения	Научно-технический центр
	Должность	Начальник НТЦ
7	Основные публикации в области диссертационного исследования:	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Слипченко С.О., Подоскин А.А., Шушканов И.В., Крючков В.А., Ризаев А.Э., Кондратов М.И., Гришин А.Е., Пихтин Н.А., Багаев Т.А., Светогоров В.Н., Ладугин М.А., Мармалюк А.А., Симаков В.А. Тиристорные ключи на основе гетеро- и гомоструктур (Al)GaAs/GaAs для генерации наносекундных импульсов тока с высокой частотой // Письма в журнал технической физики. 2024. Т.50. №4. С. 43-46 2. S.O. Slipchenko, A.A. Podoskin, I.V. Shushkanov, M.G. Rastegaeva, A.E. Rizaev, M.I. Kondratov, A.E. Grishin, N.A. Pikhtin, T.A. Bagaev, M.A. Ladugin, A.A. Marmalyuk, V.A. Simakov Hetero-integrated High Peak Optical Power Laser Source (940nm) for ToF Sensors // Chinese Optics Letters, 22, №7 (2024) 072501 3. Подоскин А.А., Шушканов И.В., Слипченко С.О., Пихтин Н.А., Багаев Т.А., Светогоров В.Н., Рябоштан Ю.Л., Ладугин М.А., Мармалюк А.А., Симаков В.А. Гибридные сборки тиристорный ключ-полупроводниковый лазер на основе гетероструктур Al-In-Ga-As-P/InP для мощных импульсных источников лазерного излучения (1400-1500 нм) // Физика и техника полупроводников. 2024. Т. 58. №3. С. 165-170 4. Slipchenko S.O., Podoskin A.A., Gavrina P.S., Kirichenko Yu.K., Shuvalova N.V., Rudova N.A., Kapitonov V.A., Leshko A.Yu., Shushkanov I.V., Zolotarev V.V., Kryuchkov V.A., Pikhtin N.A., Bagaev T.A., Yarotskaya I.V., Svetogorov V.N., Ryaboshstan Yu.L., Ladugin M.A., Marmalyuk A.A., Simakov V.A. Low-voltage InP heterostyrictors for 50–150 ns current pulses generation // Technical Physics Letters. (2023) T. 49. № S3. С. S231-S234. 5. Danilov A.I., Ivanov A.V., Konyaev V.P., Kurnvavko Yu.V., Ladugin M.A., Lobintsov A.V., Marmalyuk A.A., Sapozhnikov S.M., Simakov V.A. Semiconductor lasers with improved lasing characteristics // Bulletin of the Lebedev Physics Institute. 2023. Т. 50. № S4. С. S405-S417. 6. Слипченко С.О., Романович Д.Н., Гаврина П.С., Веселов Д.А., Багаев Т.А., Ладугин М.А., Мармалюк А.А., Пихтин Н.А. Мощные импульсные полупроводниковые лазеры (910 нм) мезаполосковой конструкции со сверхширокой излучающей апертурой на основе туннельно-связанных гетероструктур InGaAs/AlGaAs/GaAs // Квантовая электроника. (2022) Т. 52. № 2. 	

C. 174-178. [Slipchenko S.O., Romanovich D.N., Gavrina P.S., Veselov D.A., Bagaev T.A., Ladugin M.A., **Marmalyuk A.A.**, Pikhtin N.A. High-power mesa-stripe semiconductor lasers (910 nm) with an ultra-wide emitting aperture based on tunnel-coupled InGaAs/AlGaAs/GaAs heterostructures // Quantum Electronics. (2022) T. 52. № 2. С. 174-178]

7. Н. А. Волков, К. Ю. Телегин, Н. В. Гультиков, Д. Р. Сабитов, А. Ю. Андреев, И. В. Яроцкая, А. А. Падалица, М. А. Ладугин, **А. А. Мармалюк**, Л. И. Шестак, А. А. Козырев, В. А. Панарин. Улучшение параметров вольт-амперной характеристики полупроводниковых лазеров InGaAs/AlGaAs/GaAs ($\lambda = 940-980$ нм) с расширенным асимметричным волноводом // Квантовая электроника, 52:2 (2022), 179–181 [N. A. Volkov, K. Yu. Telegin, N. V. Gultikov, D. R. Sabitov, A. Yu. Andreev, I. V. Yarotskaya, A. A. Padalitsa, M. A. Ladugin, **A. A. Marmalyuk**, L. I. Shestak, A. A. Kozyrev, V. A. Panarin. Improvement of the current-voltage performance of broadened asymmetric waveguide InGaAs/AlGaAs/GaAs semiconductor lasers ($\lambda = 940-980$ nm) // Quantum Electron., 52:2 (2022), 179–181]
8. Т. А. Багаев, Н. В. Гультиков, М. А. Ладугин, **А. А. Мармалюк**, Ю. В. Курнявко, В. В. Кричевский, А. М. Морозюк, В. П. Коняев, В. А. Симаков, С. О. Слипченко, А. А. Подоскин, Н. А. Пихтин, А. Е. Казакова, Д. Н. Романович, В. А. Крючков. Мощные полупроводниковые гибридные импульсные лазерные излучатели в диапазоне длин волн 900–920 нм // Квантовая электроника, 51:10 (2021), 912–914 [T. A. Bagaev, N. V. Gul'tikov, M. A. Ladugin, **A. A. Marmalyuk**, Yu. V. Kurnyavko, V. V. Krichevskii, A. M. Morozyuk, V. P. Konyaev, V. A. Simakov, S. O. Slipchenko, A. A. Podoskin, N. A. Pikhtin, A. E. Kazakova, D. N. Romanovich, V. A. Kryuchkov. High-power pulsed hybrid semiconductor lasers emitting in the wavelength range 900–920 nm // Quantum Electron., 51:10 (2021), 912–914]
9. Ю. К. Бобрецова, Д. А. Веселов, А. А. Подоскин, Н. В. Воронкова, С. О. Слипченко, М. А. Ладугин, Т. А. Багаев, **А. А. Мармалюк**, Н. А. Пихтин. Экспериментальная методика исследования оптического поглощения в волноводных слоях полупроводниковых лазерных гетероструктур // Квантовая электроника, 51:2 (2021), 124–128 [Yu. K. Bobretsova, D. A. Veselov, A. A. Podoskin, N. V. Voronkova, S. O. Slipchenko, M. A. Ladugin, T. A. Bagaev, **A. A. Marmalyuk**, N. A. Pikhtin. Experimental technique for studying optical absorption in waveguide layers of semiconductor laser heterostructures // Quantum Electron., 51:2 (2021), 124–128]
10. Асланян А.Э., Авакянц Л.П., Червяков А.В., Туркин А.Н., Мирзаи С.С., Курешов В.А., Сабитов Д.Р., **Мармалюк А.А.** Исследование напряженности внутренних электрических полей в активной области светодиодных структур на основе InGaN/GaN с разным числом квантовых ям методом спектроскопии электропропускания // Физика и техника полупроводников. 2020. Т. 54. No4. С. 420-425.
11. Асланян А.Э., Авакянц Л.П., Червяков А.В., Туркин А.Н., Курешов В.А., Сабитов Д.Р., **Мармалюк А.А.** Фотореверсивный ток в светодиодных гетероструктурах на основе InGaN/GaN с разным количеством квантовых ям // Физика и техника полупроводников. 2020. Т. 54. No3. С. 292-295.

8 Контактный телефон члена экспертной комиссии (желательно мобильный)

9 Адрес электронной почты